

ТИРИСТОРЫ

T115-6,3, T115-10, T115-16



Общие сведения

Тиристоры Т115 выпускают на токи 6,3 , 10 и 16 А напряжением от 200 до 1200 В в пластмассовом корпусе с беспотенциальным основанием фланцевого исполнения.

Тиристоры предназначены для работы в силовых цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц различных электромеханических устройств.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения У2 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69.

Тиристоры предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных и химически неактивных средах, в условиях исключающих воздействие различных излучений (нейтронного, электронного, гамма-излучения).

Тиристоры допускают воздействие вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с ускорением 50 м/с² и одиночных ударов длительностью импульса 50мс и ускорением 40 м/с². Группа М27 условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90.

Тиристоры по своим параметрам и характеристикам соответствуют ТУ У 32.1-30077685-005-2002.

Комплектность поставки и формулирование заказа

Тиристоры поставляются без охладителей, но по согласованию с предприятием-изготовителем могут поставляться с охладителем и комплектом крепежных деталей.

К каждой партии тиристоров, транспортируемых в один адрес, прилагается этикетка.

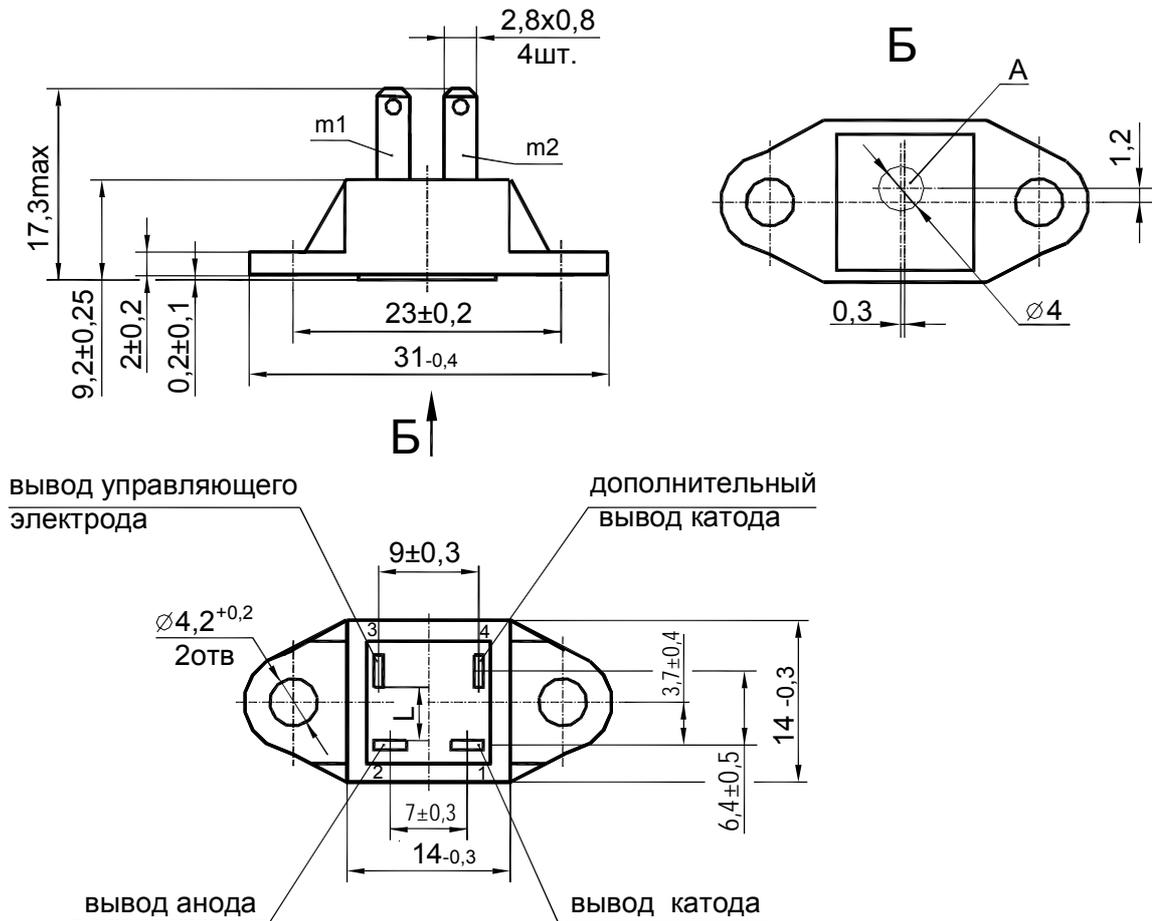
При заказе тиристоров необходимо указать:

тип, класс, группу по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии климатическое исполнение, категорию размещения, комплектность поставки, количество, номер технических условий.

Пример заказа 50 штук тиристоров типа Т115-10 восьмого класса, с критической скоростью нарастания напряжения в закрытом состоянии по шестой группе.

T115-10-8-6 ТУ У 32.1-30077685-005-2002 ТУ 50 шт, без охладителей.

Конструкция тиристоров



А - область контроля температуры корпуса тиристора;
m1,m2 - контрольные точки измерения импульсного напряжения в открытом состоянии;
L - минимальное расстояние по воздуху между выводом анода и выводом управляющего электрода и длина пути для тока утечки между этими выводами 4.1 мм;

Масса, кг, не более - 0,005

Предельно допустимые значения параметров тиристоров

| Буквенное обозначение | Параметр и единица измерения | Значение параметра | | | Условия установления норм на параметры |
|---------------------------------------|--|--------------------|---|---------|---|
| | | Тип тиристора | | | |
| | | T115-6,3 | T115-10 | T115-16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| U_{DRM} U_{RRM} | Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 2 4 5 6 8 9 10 11 12 | | 200 400 500 600 800 900 1000 1100 1200 | | $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ $T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный длительностью 10 мс, частота 50 Гц |
| U_{DSM} U_{RSM} | Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 2 4 5 6 8 9 10 11 12 | | 225 450 560 670 900 1000 1100 1200 1300 | | $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ $T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный, одиночный, длительностью 10 мс. Цепь управления разомкнута |
| U_{DWM} U_{RWM} | Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В | | $0,8 U_{DRM}$ $0,8 U_{RRM}$ | | $T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный длительностью 10 мс, частота 50 Гц |
| U_D U_R | Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В | | $0,6 U_{DRM}$ $0,6 U_{RRM}$ | | $T_c = 75\text{ }^\circ\text{C}$ |
| I_{TAVM} | Максимально допустимый средний прямой ток в открытом состоянии, А | 6,3 | 10 | 16 | $T_c = 75\text{ }^\circ\text{C}$ Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц |
| I_{TRMS} | Действующий ток в открытом состоянии, А | 10 | 16 | 25 | $T_c = 75\text{ }^\circ\text{C}$ |
| I_{TSM} | Ударный ток в открытом состоянии, А, не менее | 100 | 140 | 220 | $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ $U_R = 0$ |
| | | 90 | 130 | 200 | $T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный, одиночный длительностью 10 мс $I_G = I_{GT}$ при $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ |
| $\left(\frac{di_T}{dt}\right)_{crit}$ | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс, не менее | | 100 | | $T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 0,67 U_{DRM}$, $I_T = 2 I_{TAVM}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 1-5 Гц. Режим цепи управления: форма - трапецеидальная; длительность импульса тока не менее 50 мкс; амплитуда - $3I_{GT}$; длительность фронта 1 мкс. Внутреннее сопротивление источника управления не более 30 Ом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------|---|---|---|---|--|
| R_{IG} | Сопротивление изоляции между беспотенциальным основанием тиристора и его выводами, МОм, не менее | 30 | | | Повышенная влажность (более 80 %) Напряжение 1000 В. Время приложения испытательного напряжения 10 с. |
| | | 3 | | | |
| U_{IG} | Электрическая прочность изоляции между беспотенциальным основанием и выводами, кВ, (действующее значение) | 2,0 (для 2-8 кл.) 2,5 (для 9-12 кл.) | | | Напряжение синусоидальное, частота 50 Гц. Время выдержки под напряжением – 60 с. Основные выводы закорочены между собой. |
| T_{jm} T_{jmin} | Температура перехода: максимальное значение, °С минимальное значение, °С | 125 минус 40 | | | |
| T_{stgmax} T_{stgmin} | Температура хранения: максимальное значение, °С минимальное значение, °С | 50 минус 60 | | | |

Характеристики и параметры тиристоров

| Буквенное обозначение | Наименование, единица измерения | Значение параметра | | | Условия установления норм на параметры |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------|---------|---|
| | | Тип тиристора | | | |
| | | T115-6,3 | T115-10 | T115-16 | |
| U_{TM} | Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более | 1,80 | 1,75 | 1,70 | $T_j = 25\text{ °C}$; $I_T = 3,14I_{TAVM}$ |
| $U_{T(ГО)}$ | Пороговое напряжение в открытом состоянии, В | 1 | | | $T_{jm} = 125\text{ °C}$ |
| r_T | Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом | 0,040 | 0,024 | 0,014 | $T_{jm} = 125\text{ °C}$ |
| I_{DRM} I_{RRM} | Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии и повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более | 1,7 2,5 | | | $T_j = 25\text{ °C}$; $T_{jm} = 125\text{ °C}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_D = U_{DRM}$; Цепь управления разомкнута |
| $\left(\frac{du_d}{dt}\right)_{crit}$ | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы: 1 2 3 4 5 6 | 20 50 100 200 320 500 | | | $T_j = 125\text{ °C}$; $U_{DM} = 0,67U_{DRM}$; $t_{u\ min} = 200\text{ мкс}$ Цепь управления разомкнута |
| t_q | Время выключения, мкс, не более | 160 | | | $T_{jm} = 125\text{ °C}$; $I_T = I_{TAVM}$; $\left(\frac{di}{dt}\right)_f = 5\text{ А/мкс}$; $\frac{du_d}{dt} = 50\text{ В/мкс}$; $U_R = 100\text{ В}$; $U_{DM} = 0,67U_{DRM}$ |
| U_{GT} | Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее | 2,5 | | | $T_j = 25\text{ °C}$; $U_D = 12\text{ В}$ |
| | | 3,5 | | | $T_{jmin} = \text{минус } 40\text{ °C}$; $U_D = 12\text{ В}$ |
| I_{GT} | Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более | 45 | | | $T_j = 25\text{ °C}$; $U_D = 12\text{ В}$ |
| | | 120 | | | $T_{jmin} = \text{минус } 40\text{ °C}$; $U_D = 12\text{ В}$ |
| U_{GD} | Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее | 0,30 | | | $T_{jm} = 125\text{ °C}$; $U_D = 0,67U_{DRM}$ |
| I_H | Ток удержания, мА, не более | 70 | | | $T_j = 25\text{ °C}$; $U_D = 12\text{ В}$ Цепь управления разомкнута |
| R_{thjc} | Тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт, не более | 3,0 | 2,5 | 1,9 | Постоянный ток |

Характеристики и параметры тиристоров с рекомендуемым охладителем

| Буквенное обозначение | Наименование, единица измерения | Значение параметра | | | Условия установления норм на параметры |
|-----------------------|---|--------------------|---------|---------|---|
| | | Тип тиристора | | | |
| | | T115-6,3 | T115-10 | T115-16 | |
| I_{TAV} | Средний ток в открытом состоянии, А | 3,0 | 3,5 | 3,8 | Естественное охлаждение, $T_a = 40$ °C Ток синусоидальный, частота 50 Гц |
| R_{thja} | Тепловое сопротивление переход-среда, °C/Вт, не более | 21,2 | 20,7 | 20,1 | Естественное охлаждение, $T_a = 40$ °C Постоянный ток |
| R_{thch} | Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °C/Вт, не более | 0,20 | | | Естественное охлаждение. Постоянный ток |

Примечание - Рекомендуемый охладитель для тиристоров T115 - алюминиевая пластинка площадью 16 см², толщиной не менее 0,5 мм. Тепловое сопротивление охладителя должно быть не более 18 °C/Вт. Материал охладителя должен иметь теплопроводность не менее 210 Вт/(м·°C)